

(중소기업/국공립연구소) 공정 및 장비 사용료

1. 일반적 요금 원칙

2022. 09. 30.

| 할인종류 | | 할인요율 | | | 비고 |
|--------------------|----------------|---|--------|---|---|
| | | 직접 공정 | | 의뢰 공정 | |
| 일반 할인 | 중소기업 국공립연구소 | 20% 할인 | | 20% 할인 | - Calibration 회에 대해서는 담당 기사 승인 시 요금 부과 없음. - 외부대학 10% 추가 할인 - 교육사업과제 10% 추가 할인 |
| | 학계 | 40% 할인 | | 30% 할인 | |
| 대규모 / 장기 사용자 할인 | | 학계 | | 기업체 | - 계정 책임자에 대한 모든 공정 및 장비 사용료를 합한 금액에 대해 적용 - 장기사용자라 함은 월 200만원 이상 공정처리비를 납부하고, 3개월 연속으로 이용한 사용자 |
| | | - 월 사용료가 200만원 이상의 경우 초과분에 대해 10% 할인 | | - 월 사용료가 300만원 이상의 경우 초과분에 대해 10% 할인 | |
| | | - 월 사용료가 300만원 이상의 경우 초과분에 대해 20% 할인 - 장기사용자는 30% 할인 | | - 월 사용료가 450만원 이상의 경우 초과분에 대해 20% 할인 - 장기사용자는 25% 할인 | |
| | | - 월 사용료가 600만원 이상의 경우 초과분에 대해 30% 할인 - 장기사용자는 50% 할인 | | - 월 사용료가 900만원 이상의 경우 초과분에 대해 30% 할인 - 장기사용자는 40% 할인 | |
| | | - 월 사용료가 1,000만원 이상의 경우 초과분에 대해 40% 할인 - 장기사용자는 80% 할인 | | - 월 사용료가 1,500만원 이상의 경우 초과분에 대해 40% 할인 - 장기사용자는 60% 할인 | |
| | | | | | |
| 공정 Wafer 수량별 추가 할인 | | 6~10장 | 11~20장 | 21장 이상 | - 단, Batch 공정은 수량별 할인을 적용 제외. |
| | | 5% | 10% | 20% | |

2. 공정 장비

| 공정 명 및 장비 명 | 분 류 | 요 금 | | 비 고 | 담당자 |
|---|-----|----------------------------------|--|---|-----|
| | | 직접 사용 | 의뢰 공정 | | |
| Wet Station, CMOS, RCA Clean | 기본료 | 72,000/회 | 96,000/회 | - 화공약품 가격 포함 | 김건주 |
| Wet Station, CMOS, (BOE, Al 식각, H3PO4, Develop, Strip) | 기본료 | 72,000/회 | 96,000/회 | - 화공약품 가격 포함 | 김건주 |
| Wet Station, MEMS, SPM Cleaning | 기본료 | 40,000/회 | 64,000/회 | - 화공약품 가격 포함 | 김건주 |
| Wet Station, MEMS, (Develop, Strip) | 기본료 | 40,000/회 | 64,000/회 | - 화공약품 가격 포함 | 김건주 |
| Wet Station 학생용 C2 지역(No Bath Type) | 기본료 | 112,000/학기당 or 24,000 / 월 | 24,000 / wf | - 사전 협의된 공정만 가능 - 공용으로 제공되는 화공약품 사용료 포함 금액 | 김건주 |
| (노광 장비) E-Beam III Lithography, JEOL | 기본료 | 264,000/1시간 기본 이후 132,000/30분 | 440,000/1시간 기본 이후 220,000/30분 | -장비 Log-in 시간에 따라 부과 | 신인성 |
| Maskless Pattern System | 기본료 | 3,200/min | 40,000/기본 4,000/min | - | 박유경 |
| Maskless Pattern System II (DL-1000HP C2R10) | 기본료 | 2,400/min | 40,000/기본 2,960/min | 사용자교육: 50,000/기본 3,700/min | 박유경 |
| MA - 6 II | 기본료 | 1,120/min | 1,920/min (1'st 작업 28,800/wf Align 작업 38,400/wf) | -조각시편 ~ 6" Wafer 사용가능 -공정의뢰는 1장 15분 요금 청구 -Align 공정은 1장 20분 요금 청구 -PR Coating, Develop 별도 청구 | 박유경 |

| 공정 명 및 장비 명 | 분 류 | 요 금 | | 비 고 | 담당자 |
|---------------------------------------|-----|---------------------------|--|--|-----|
| | | 직접 사용 | 의뢰 공정 | | |
| MA - 6 III | 기본료 | 1,600/min | 2,400/min (1'st 작업 36,000/wf Align 작업 48,000/wf) | -조각 ~ 6" Wafer 사용가능. -공정의뢰는 1장 15분 요금 청구 -Align 공정은 1장 20분 요금 청구 -PR Coating, Develop 별도 청구 | 박유경 |
| Super Inkjet Printer | 기본료 | 36,000/시간 | 52,000/시간 | | 박유경 |
| P-5000 III (PR-Ashing) | 기본료 | 16,000/wf | 32,000/wf | -장당 기본료 추가 | 박종승 |
| Tepla 300 | 기본료 | 56,000/wf (25wf 이하) | 80,000/wf (25wf 이하) | -1회 사용요금 Batch(25장) 요금 | 박종승 |
| PR Asher I | 기본료 | 28,000/wf (3wf 이하) | 40,000/wf (3wf 이하) | -Batch(3)장 요금 MEMS 공정 | 신인성 |
| PR Asher II | 기본료 | 56,000/회 (25wf 이하) | 80,000/회 (25wf 이하) | -Batch(3)장 요금 MEMS 공정 | 신인성 |
| PR Asher III | 기본료 | 56,000/회 (25wf 이하) | 80,000/회 (25wf 이하) | -Batch(25)장 요금 MEMS 공정 | 신인성 |
| Spinner | 기본료 | 9,600/wf | 14,400/wf | | 박유경 |
| (산화/확산 장비) Furnace, Si CMOS | 기본료 | 200,000/회 | 320,000/회 | *추가요금(200nm 이하) -시간당 : 20,000/시간 -200nm초과시에는 기본료 재부과 | 김조원 |
| Vertical Mini Furnace | 기본료 | 200,000/회 | 320,000/회 | *추가요금(200nm 이하) -시간당 : 20,000/시간 -200nm초과시에는 기본료 재부과 | 정숙진 |
| Furnace, MEMS | 기본료 | 200,000/회 | 320,000/회 | *추가요금(200nm 이하) -시간당 : 20,000/시간 -200nm초과시에는 기본료 재부과 | 김조원 |
| Mini Furnace | 기본료 | 96,000/회 | 160,000/회 | *추가요금(200nm 이하) -시간당 : 20,000/시간 -200nm초과시에는 기본료 재부과 | 정숙진 |
| BOX FURNACE | 기본료 | 32,000/회 | 48,000/회 | *700℃ 이하 공정만 가능 -시간당 20,000 추가 | 정숙진 |
| MEMS ALD | 기본료 | 64,000/1회 | 80,000/1회 | - 100 Å/1회 이하 증착 - 100 Å 이상 시 사전협의 - 매 100 Å 이상 시 1회분 공정비용 추가 | 장래혁 |
| MEMS ALD II | 기본료 | 64,000/1회 | 80,000/1회 | - 100 Å/1회 이하 증착 - 100 Å 이상 시 사전협의 - 매 100 Å 이상 시 1회분 공정비용 추가 | 장래혁 |
| Ion Implanter | 기본료 | 160,000/기본 + 48,000/wf | 240,000//기본 + 72,000/wf | *추가요금 -High Dose(1e15이상)시 기본료*50% -High Dose(5e15이상)시 wf장 당*50% | 장래혁 |
| RTP(CMOS, Si) | 기본료 | 48,000/wf | 72,000/wf | | 김조원 |
| RTA(CMOS Silicide) | 기본료 | 48,000/wf | 72,000/wf | | 김조원 |
| RTA II(화합물, KVT) | 기본료 | 40,000/wf | 64,000/wf | -시편 가능 | 김조원 |
| RTA(화합물, 서광석) | 기본료 | 32,000/wf | 3 48,000/wf | -시편 가능 | 김조원 |

| 공정 명 및 장비 명 | 분 류 | 요 금 | | 비 고 | 담당자 |
|--------------------------------------|-----|--|--|--|-----|
| | | 직접 사용 | 의뢰 공정 | | |
| (증착장비) LPCVD I MTO | 기본료 | 200,000/회 +16,000/100 Å (MTO) | 320,000/회 +16,000/100 Å (MTO) | *추가요금은 직업, 의뢰 구분없이 동일 적용 -MTO 1000 Å이하 가능 | 정숙진 |
| LPCVD I Poly | 기본료 | 200,000/회 +24,000/1000 Å (Poly) | 320,000/회 +24,000/1000 Å (Poly) | *추가요금은 직업, 의뢰 구분없이 동일 적용 -Poly 1µm이하 가능 | 정숙진 |
| LPCVD I Nitride | 기본료 | 200,000/회 +16,000/500 Å (Nitride) | 320,000/회 +16,000/500 Å (Nitride) | *추가요금은 직업, 의뢰 구분없이 동일 적용 -Nitride 1µm이하가능 | 정숙진 |
| LPCVD III Poly (SHF-150/L 셀트론) | 기본료 | 200,000/회 +24,000/1000 Å (Poly) | 320,000/회 +24,000/1000 Å (Poly) | *추가요금은 직업, 의뢰 구분없이 동일 적용 -Poly 1µm이하 가능 | 정숙진 |
| LPCVD III Nitride (SHF-150/L 셀트론) | 기본료 | 200,000/회 +16,000/500 Å (Nitride) | 320,000/회 +16,000/500 Å (Nitride) | *추가요금은 직업, 의뢰 구분없이 동일 적용 -Nitride 350nm이하 가능 | 정숙진 |
| LPCVD(리드) Poly | 기본료 | 200,000/회 +24,000/1,000 Å | 320,000/회 +24,000/1,000 Å | *추가요금은 직업, 의뢰 구분없이 동일 적용 | 정숙진 |
| LPCVD(리드) D-Poly | 기본료 | 200,000/회 +24,000/1,000 Å | 320,000/회 +24,000/1,000 Å | *추가요금은 직업, 의뢰 구분없이 동일 적용 | 정숙진 |
| LPCVD(리드) Nitride | 기본료 | 200,000/회 +16,000/500 Å | 320,000/회 +16,000/500 Å | *추가요금은 직업, 의뢰 구분없이 동일 적용 | 정숙진 |
| LPCVD(리드) MTO | 기본료 | 200,000/회 +16,000/100 Å | 320,000/회 +16,000/100 Å | *추가요금은 직업, 의뢰 구분없이 동일 적용 | 정숙진 |
| HDCVD EUREKA, 2000(주성엔지니어링) | 기본료 | 56,000/wf | 80,000/wf | -두께 500nm이하를 기준으로 함. (증착 시 100nm단위로 기본비용 추가정산) 100nm/30,000 | 정숙진 |
| PECVD, STS | 기본료 | 56,000/30min(기본) + 40,000/30min(추가) | 80,000/30min(기본) + 56,000/30min(추가) | -Batch(4wf)공정 | 김정민 |
| Ox ford PECVD | 기본료 | 56,000/30min(기본) + 40,000/30min(추가) | 80,000/30min(기본) + 56,000/30min(추가) | | 김정민 |
| HW-CVD | 기본료 | 56,000/60min(기본) + 40,000/60min(추가) | 80,000/60min(기본) + 56,000/60min(추가) | | 김정민 |
| P-5000 II MEMS용 TEOS 증착 | 기본료 | 56,000/wf | 80,000/wf | *추가요금 -1µm 이상 : 5000/100nm | 이 규 |
| MOCVD InP | 기본료 | 240,000/회 | 320,000/회 | | - |
| MOCVD GaN | 기본료 | 240,000/회 | 320,000/회 | | - |
| BMR ICP CVD | 기본료 | 80,000/시간 | 120,000/시간 | *추가요금 -1시간 초과 시 30분당 35,000 | 김조원 |
| Endura Sputter 5500 | 기본료 | 48,000/기본 +32,000/wf | 64,000/기본 + 40,000/wf | *추가요금 [Ti, Tin] -100nm초과시 : 10,000/100nm [Al] -500nm초과시 : 10,000/100nm | 김윤빈 |
| Endura Sputter 5500 (2호기) | 기본료 | 48,000/기본 +32,000/wf | 64,000/기본 + 40,000/wf | *추가요금 [Ti, Tin] -100nm초과시 : 10,000/100nm [Al] -500nm초과시 : 10,000/100nm | 김윤빈 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| Metal Sputter | 기본료 | 48,000/기본 +32,000/wf | 64,000/기본 + 40,000/wf | *추가요금 -100nm초과 시 5000 | 장래혁 |
| Metal Sputter(PT) | 기본료 | 48,000/기본 +48,000/wf | 64,000/기본 + 64,000/wf | *추가요금 -50nm초과 시 30,000 | 장래혁 |
| Metal Sputter SRN120 | 기본료 | 48,000/기본 +32,000/wf | 64,000/기본 + 40,000/wf | *추가요금 -100nm초과 시 5000 | 장래혁 |
| Sputter SNTTEK | 기본료 | 48,000/기본 +32,000/wf | 64,000/기본 + 40,000/wf | *추가요금 -100nm초과 시 5000 | 김윤빈 |
| Wavics Sputter | 기본료 | 48,000/기본 +32,000/wf | 64,000/기본 + 40,000/wf | *추가요금 -100nm초과 시 5000 | 김윤빈 |
| Au Sputter | 기본료 | 48,000/기본 +48,000/wf | 64,000/기본 + 64,000/wf | *추가요금 -50nm초과시 30,000 | 장래혁 |
| Thermal evaporator | 기본료 | 48,000/회 | 80,000/회 | *추가요금 -2시간 초과 시 1횟수 추가 | 이희나 |
| E-gun evaporator(Sorona I) | 기본료 | 40,000/회 | 60,000/회 | *추가요금 -2시간/1 μ m 초과 시 1횟수 추가 | 이희나 |
| E-gun evaporator(Sorona II) | 기본료 | 80,000/회 | 120,000/회 | *추가요금 -2시간/1 μ m 초과 시 1횟수 추가 | 이희나 |

| 공정 명 및 장비 명 | 분 류 | 요 금 | | 비 고 | 담당자 |
|---|-----|------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| | | 직접 사용 | 의뢰 공정 | | |
| (식각장비) CDE (Si, SiO2, Si3N4) 표면처리 | 기본료 | 56,000/wf | 80,000/wf | -Bulk Etch | 박종승 |
| P-5000 II Etcher MEMS용 | 기본료 | 56,000/wf | 80,000/wf | | 이 규 |
| ICP Poly Etcher, STS I | 기본료 | 56,000/wf | 80,000/wf | | 황승욱 |
| ICP Poly Etcher, STS II | 기본료 | 56,000/wf | 80,000/wf | | 박종승 |
| Deep Si Etcher I, II | 기본료 | 120,000/wf (50 μ m이하) | 160,000/wf (50 μ m 이하) | *추가요금 -150 μ m이하 : 12,000/10 μ m -150 μ m이상 : 7,200/10 μ m | 박종승 |
| ICP GaN Etcher, 선익 | 기본료 | 56,000/wf | 80,000/wf | 기본 30분 -초과 시 18,000/30분 | 박종승 |
| Oxford ICP Etcher | 기본료 | 32,000/기본 +19,200/30min | 48,000/기본 +28,800/30min | | 황승욱 |
| OXford Etcher (실리콘, 화합물) | 기본료 | 32,000/기본 +19,200/30min | 48,000/기본 +28,800/30min | *추가요금 -장비 Log in 시간에 따라 요금 부과 | 황승욱 |
| MEMS Poly Etcher, STS MEMS Metal Etcher, STS | 기본료 | 56,000/wf | 80,000/wf | *추가요금 -wf 장당 MEMS 공정 | 황승욱 |
| BMR ICP Etcher | 기본료 | 56,000/시간 | 80,000/시간 | *추가요금 -1시간 초과 시 30분당 35,000 | 황승욱 |
| CMP(SiO2) | 기본료 | 48,000/wf +800/min | 96,000/wf +800/min | -재료비 포함 | 황승욱 |
| (기타 공정장비) Dicing Saw I | 기본료 | 24,000/wf | 24,000/wf +24,000/시간 | -Qurtz, Glass -기판두께 1 μ m이하 가능 -시편은 5ea/1장 -기타 기판은 협의 | 김건주 |
| Dicing Saw II | 기본료 | 20,000/wf | 20,000/wf +24,000/시간 | -Si 전용 -시편5ea/1장 -기타 기판은 협의 | 김건주 |
| Parylene Deposition (PDS 2010) | 기본료 | 80,000/회 | 120,000/회 | | 지상엽 |
| Wire Ball Bonder | 기본료 | 24,000/시간 | 36,000/시간 | *추가요금 -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 -Wefge. Capillary 본인 부담 | 김조원 |
| Wire Wedge Bonder | 기본료 | 24,000/시간 | 36,000/시간 | *추가요금 -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 -Wefge. Capillary 본인 부담 | 김조원 |

6" 공정 장비

| 공정 명 및 장비 명 | 분 류 | 요 금 | | 비고 | 담당자 |
|--------------------------------------|-----|--|--|---|-----|
| | | 직접 사용 | 외뢰 공정 | | |
| (증착 장비) Endura Sputter 5500 | 기본료 | 48,000/기본 +32,000/wf | 64,000/기본 + 40,000/wf | *추가요금 [Ti, Tin] -100nm 초과시 : 10,000/100nm [Al] -500nm 초과시 10,000/100nm | 김윤빈 |
| Endura Sputter 5500 (2호기) | 기본료 | 48,000/기본 +32,000/wf | 64,000/기본 + 40,000/wf | *추가요금 [Ti, Tin] -100nm 초과시 : 10,000/100nm [Al] -500nm 초과시 10,000/100nm | 김윤빈 |
| Au Sputter | 기본료 | 48,000/기본 +48,000/wf | 64,000/기본 + 64,000/wf | *추가요금 -50nm초과시 30,000 | 장래혁 |
| E-gun Evaporator | 기본료 | 80,000/회 | 120,000/회 | *추가요금 -2시간/1 μ m 초과 시 1회수 추가 | 이희나 |
| P-5000 4호기 CVD | 기본료 | 56,000/wf | 80,000/wf | *추가요금 -1 μ m이상 : 5,000/100nm | 김정민 |
| LPCVD III Poly (SHF-150/L 셀트론) | 기본료 | 200,000/회 +24,000/1000 Å (Poly) | 320,000/회 +24,000/1000 Å (Poly) | *추가요금은 직업, 외뢰 구분없이 동일 적용 -Poly 1 μ m이하 가능 | 정숙진 |
| LPCVD III Nitride (SHF-150/L 셀트론) | 기본료 | 200,000/회 +16,000/500 Å (Nitride) | 320,000/회 +16,000/500 Å (Nitride) | *추가요금은 직업, 외뢰 구분없이 동일 적용 -Nitride 350nm이하 가능 | 정숙진 |
| HDPCVD EUREKA, 2000(주성엔지니어링) | 기본료 | 56,000/wf | 80,000/wf | -두께 500nm이하를 기준으로 함. (증착 시 100nm단위로 기본비용 추가정산) 100nm/30,000 | 정숙진 |
| CMOS HDP CVD | 기본료 | 56,000/wf | 80,000/wf | 기본요금: 500nm 이하 *추가요금: 30,000/100nm | 정숙진 |
| STS PECVD | 기본료 | 56,000/30min(기본) + 40,000/30min(추가) | 80,000/30min(기본) + 56,000/30min(추가) | -Batch(4wf)공정 | 김정민 |
| HW-CVD | 기본료 | 56,000/60min(기본) + 40,000/60min(추가) | 100,000/60min(기본) + 56,000/60min(추가) | | 김정민 |
| (산화/확산 장비) Furnace, Si CMOS | 기본료 | 200,000/회 | 320,000/회 | *추가요금(200nm 이하) -시간당 : 20,000/시간 -200nm초과시에는 기본료 재부과 | 김조원 |
| 원릭IPS CMOS ALD | 기본료 | 64,000/1회 | 80,000/1회 | - 100 Å/1회 이하 증착 - 매 100 Å 이상 증착 시 1회분 공정비용 추가 | 장래혁 |
| Vertical Mini Furnace | 기본료 | 200,000/회 | 320,000/회 | *추가요금(200nm 이하) -시간당 : 20,000/시간 -200nm초과시에는 기본료 재부과 | 정숙진 |
| Ion Implanter | 기본료 | 160,000/기본 + 48,000/wf | 240,000//기본 + 72,000/wf | *추가요금 -High Dose(1e15이상)시 기본료*50% -High Dose(5e15이상)시 w장 당*50% | 장래혁 |
| (노광 장비) Nikon Stepper | 기본료 | 56,000/wf | 80,000/wf | -장당 기본료 추가 | 박유경 |
| PR Track | 기본료 | 16,000/wf | 24,000/wf | -장당 기본료 추가 | 박유경 |
| MA - 6 II | 기본료 | 1,120/min | 1,920/min (1'st 작업 28,800/wf Align 작업 38,400/wf) | -조각시편 ~ 4" Wafer 사용가능 -공정의뢰는 1장 15분 요금 청구 -Align 공정은 1장 20분 요금 청구 -PR Coating, Develop 별도 청구 | 박유경 |
| PR Asher III | 기본료 | 56,000/회 (25wf 이하) | 80,000/회 (25wf 이하) | -Batch(3)장 요금 MEMS 공정 | 신인성 |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|--|-----|
| (식각 장비) P-5000 III (Al/Ti/TiN Etch) | 기본료 | 56,000/wf | 80,000/wf | | 박종승 |
| CMOS ICP Metal Etcher | 기본료 | 56,000/wf | 80,000/wf | | 박종승 |
| P-5000 IV (SiO2/Si3N4 Etch) | 기본료 | 56,000/wf | 80,000/wf | | 박신근 |

3. 측정 장비

| 공정 명 및 장비 명 | 분 류 | 요 금 | | 비 고 | 담당자 |
|---|-----|------------|------------|--|-----|
| | | 직접 사용 | 의뢰 공정 | | |
| FE - SEM (S-5000) | 기본료 | 18,400/30분 | 54,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 | 지상엽 |
| FE - SEM II (S-4800) | 기본료 | 18,400/30분 | 54,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 | 지상엽 |
| FE-SEM (JSM 7401F) | 기본료 | 18,400/30분 | 54,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 | 지상엽 |
| Vacuum Chamber Probe Station (B1500A) | 기본료 | 6,000/10분 | 48,000/1시간 | 사용자교육: 48,000/1시간 *추가요금(의뢰시) -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 | 지상엽 |
| EDS (X선 분광 분석기) | 기본료 | 16,000/회 | 24,000/회 | *FE SEM 사용료에 추가 | 지상엽 |
| CD - SEM (S-8820) | 기본료 | 27,000/30분 | 75,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 | 박유경 |
| In-line CD SEM (VEGA GMS) | 기본료 | 21,600/30분 | 60,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 | 박유경 |
| AFM (XE - 150) | 기본료 | 4,800/10분 | 48,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 | 지상엽 |
| Hall Measurement | 기본료 | 4,000/10분 | 36,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 | 지상엽 |
| Stress Measurement I, II | 기본료 | 4,000/10분 | 36,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 | 지상엽 |
| Probe Station (4155A) | 기본료 | 4,000/10분 | 36,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 | 지상엽 |

| 공정 명 및 장비 명 | 분 류 | 요 금 | | 비 고 | 담당자 |
|---------------------------------|-----|-----------------------|------------|---|-----|
| | | 직접 사용 | 의뢰 공정 | | |
| PL (광특성평가시스템) | 기본료 | 5,600/10분 | 56,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 | 지상엽 |
| 3D Surface Profiler | 기본료 | 4,000/10분 | 50,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 | 지상엽 |
| MEMS Surface profiler | 기본료 | 30,000/시간 입소생 무료 | 30,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -시간당 기본료 추가 | 지상엽 |
| 4200-SCS | 기본료 | 4,000/10분 | 36,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 | 지상엽 |
| FT-IR | 기본료 | 4,800/10분 | 28,000/30분 | *추가요금(의뢰시) -1시간 초과시 30분당 기본료 추가 | 지상엽 |
| 4-Point probe | 기본료 | 연구소 공용장비 (입소생 무료) | 30,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -시간당 기본료 추가 | 지상엽 |
| a-step | 기본료 | 연구소 공용장비 (입소생 무료) | 30,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -시간당 기본료 추가 | 지상엽 |
| Ellipsometer | 기본료 | 연구소 공용장비 (입소생 무료) | 30,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -시간당 기본료 추가 | 지상엽 |
| MEMS Spectroscopic Ellipsometer | 기본료 | 30,000/시간 (입소생 무료) | 30,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -시간당 기본료 추가 | 지상엽 |
| Nanospec | 기본료 | 연구소 공용장비 (입소생 무료) | 30,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -시간당 기본료 추가 | 지상엽 |
| CMOS Nanospec (ST-4000 DLX) | 기본료 | 30,000/시간 (입소생 무료) | 30,000/시간 | *추가요금(의뢰시) -시간당 기본료 추가 | 지상엽 |
| Optical profiler | 기본료 | 24,000/60분 | 해당없음 | *추가요금(의뢰시) -1시간 초과 시 30분당 기본료의 1/2추가 | 지상엽 |
| 네트워크분석기 (E5071C) | 기본료 | 4,000/시간 | 8,000/시간 | | 이은경 |
| 스펙트럼분석기 (E4408B) | 기본료 | 4,000/시간 | 8,000/시간 | | 이은경 |
| 비트에러율 테스터 (MP1800A 외) | 기본료 | 8,000/시간 | 16,000/시간 | | 이은경 |